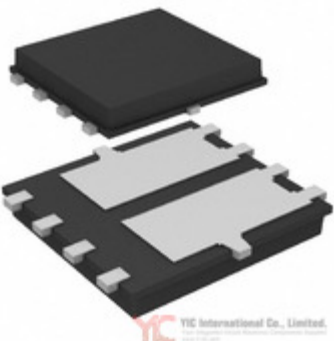

	<h2 style="color: red;">SI7232DN-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7232DN-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 25A PPAK 1212-8
	<b>Datenblätter:</b>  SI7232DN-T1-GE3.pdf
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 3183 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

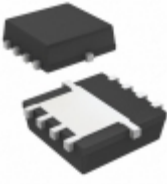



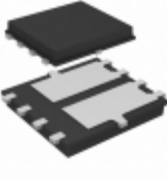

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7232DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 25A PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3183 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.4 mOhm @ 10A, 4.5V
Leistung - max	23W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Andere Namen	SI7232DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1220pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 8V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 25A 23W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A
Basisteilenummer	SI7232

SI7232DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7232DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7232DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7232DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7230DP-T1-E3</b> VISHAY VISHAY QFN1212</p>	 <p><b>SI7230DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 9A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7230DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 9A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7230E</b> SANKEN</p>
 <p><b>SI7230DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7232DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 25A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7233DN-T1-E3</b> VISHAY SI7233DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7233DN</b> SI SI7233DN SI</p>

### SI7232DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7232DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7232DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7232DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7232DN-T1-GE3
SI7232DN-T1-GE3 Electronic	SI7232DN-T1-GE3 Hersteller	SI7232DN-T1-GE3 Komponenten	SI7232DN-T1-GE3 Bild	SI7232DN-T1-GE3 Verteiler	SI7232DN-T1-GE3-Bild
SI7232DN-T1-GE3 Preis	SI7232DN-T1-GE3 Neu	SI7232DN-T1-GE3 Original	SI7232DN-T1-GE3 garantiert	SI7232DN-T1-GE3 RFQ	SI7232DN-T1-GE3 Inventar
SI7232DN-T1-GE3					SI7232DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited